

多模式、恒流恒压原边控制功率开关

主要特点

- 集成 650V MOSFET
- 支持反激型拓扑应用
- ±4% 恒流、恒压精度
- 待机功耗 <70mW
- 多模式原边控制方式
- 工作无异音
- 优化的动态响应
- 可调式线损补偿
- 集成线电压和负载电压的恒流补偿
- 集成完善的保护功能:
 - 短路保护 (SLP)
 - 过温保护 (OTP)
 - 逐周期限流保护 (OCP)
 - 前沿消隐 (LEB)
 - 管脚悬空保护
 - VDD 过欠压保护和箝位保护
- 封装形式 SOP-8、DIP-8

典型应用

- 手机充电器
- 交流适配器

典型应用电路

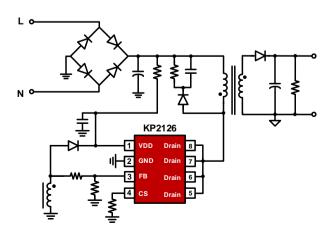
产品描述

KP2126 是一款高性能原边控制器,可提供高精度 恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率**离线**式充 电器应用中。

在恒压输出模式中,KP2126 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用 KP2126 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。

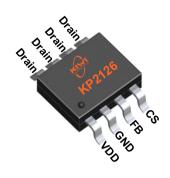
KP2126 集成有多种保护功能: VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。

充电器应用





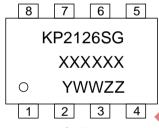
管脚封装



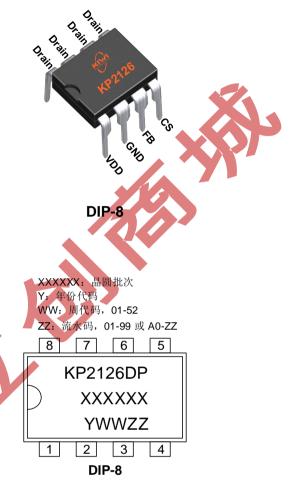
SOP-8

产品标记

XXXXXX: 晶圆批次 Y: 年份代码 WW: 周代码, 01-52 ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



SOP-8



典型功率表(1)

型号	230VAC ± 15% ⁽²⁾	85 - 265 VAC	
坐 写	适配器 ⁽³⁾	适配器 ⁽³⁾	
KP2126SG	20W	18W	
KP2126DP	27W	24W	

备注 1: 最大输出功率受限于芯片结温。

备注 2: 230VAC 或 100/115VAC 带倍压器。

备注 3: 典型功率测试条件:环境温度 Ta=50℃,IC Drain 有足够铜皮散热,适配器全密封不透风。



管脚功能描述

SOP-8 / DIP-8	名称	I/O	描述	
1	VDD	I	芯片供电管脚	
2	GND	Р	芯片地管脚	
3	FB	I	系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚, 用于 CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制	
4	cs	I	电流采样输入管脚	
5, 6, 7, 8	Drain	Р	内部功率管的漏极	

订货信息

型号	描述
KP2126SGA	SOP-8,无齿、编带盘装,4000 颗/卷
KP2126DP	DIP-8,无卤,50 颗/管





极限参数 (备注 4)

参数	数值	単位
VDD 直流供电电压	-0.3 to 34.5	V
VDD 直流箝位电流	10	mA
Drain 电压	-0.3 to 650	V
FB, SEL 电压范围	-0.7 to 7	V
CS 电压范围	-0.3 to 7	V
封装热阻结到环境 (SOP-8)	165	°C/W
封装热阻结到环境 (DIP-8)	105	°C/W
最大芯片工作结温	165	°C
储藏温度范围	-40 to 165	°C
焊接温度 (焊接, 10 s)	260	°C
ESD 人体模型	3	kV

推荐工作条件

参数	数值	单位
VDD 供电电压	11 to 27	V
芯片工作结温	-40 to 150	°C
最高工作频率 @ 满载、反激原边控制	70	kHz
最低工作频率 @ 满载、反激原边控制	35	kHz

电气参数 (TA= 25°C, VDD=18V, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位	
供电部分 (VE	供电部分 (VDD 管脚)						
IVDD_st	VDD 启动电流			2	15	uA	
IVDD_Op	VDD 工作电流	V _{FB} =1.1V, VDD=18V	0.3	0.7	0.9	mA	
IVDD_standby	VDD 静态电流			0.5	1	mA	
V _{DD_ON}	VDD 开启电压		15	16.3	17.5	V	
V _{DD_OFF}	VDD 美断电压		8	9	10	V	
V _{DD_OVP}	VDD OVP 阈值		28	30	32	V	



多模式、恒流恒压原边控制功率开关

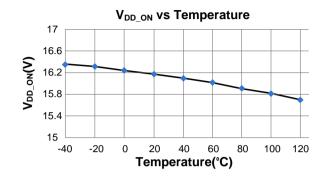
				1				
V _{DD_Clamp}	VDD 箝位电压	$I(V_{DD}) = 7 \text{ mA}$	32.5	34.5	36.5	V		
反馈控制部分	反馈控制部分 (FB Pin)							
V _{FBRE} F	内部误差放大器参考输入		1.97	2.0	2.03	V		
V _{FB_SLP}	短路保护阈值			0.7		V		
T _{FB_Short}	短路保护去抖时间			10		ms		
V _{FB_DEM}	消磁比较器阈值			20		mV		
T _{blank}	LEB 屏蔽时间	CC 模式 (备注 5)		3.5	X	us		
I blank	上口所似时间	CV 模式 (备注 5)		2/		us		
T _{off_max}	最长美断时间		3.6	4	4.5	ms		
I _{Cable_max}	最大线补电流		48	53	58	uA		
电流采样部分	►(CS 管脚)							
T _{LEB}	前沿消隐时间		7	500		ns		
V _{cs(max)}	过流保护阈值		490	500	510	mV		
T _{D_OC}	过流保护关断延时			100		ns		
过温保护								
T _{SD}	过热关机	(备注 5)		165	1	°C		
T _{RC}	热恢复	(备注 5)		135	-	°C		
功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚)								
V _{BR}	功率 MOSFET 漏源击穿电压		650			V		
I _D	内部 MOSFET 漏极电流		5			А		
R _{dson}	静态漏源导通电阻			1.6	2	Ω		

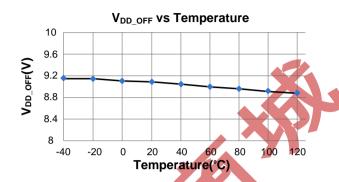
备注 4: 超出列表中极限参数可能会对芯片造成永久性损坏。极限参数为额定应力值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下,器件可能无法正常工作,所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下,会影响器件的可靠性。

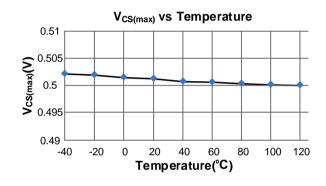
备注 5:参数取决于设计,批量生产制造时通过功能性测试。

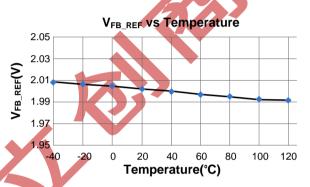


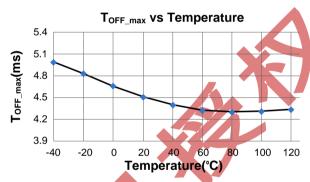
参数特性曲线

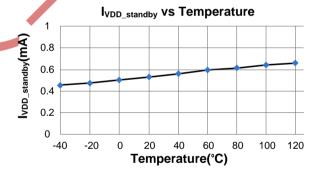








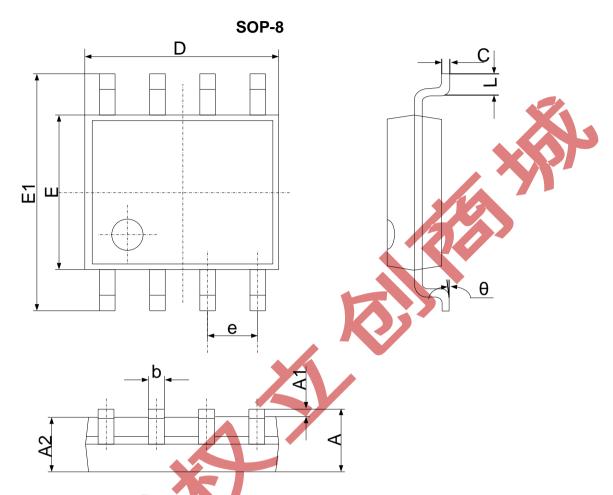








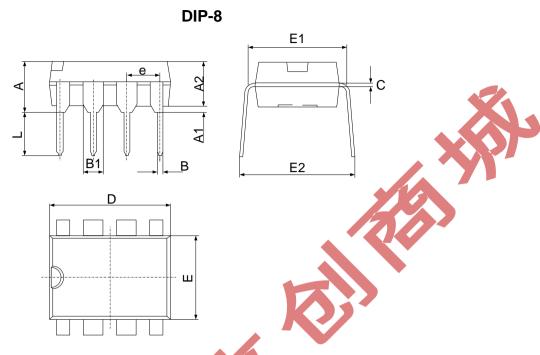
封装尺寸



符号	尺寸((毫米)	尺寸 (英寸)		
1य च	最小	最大	最小	最大	
А	1.350	1.750	0.053	0.069	
A1	0.100	0.250	0.004	0.010	
A2	1.350	1.550	0.053	0.061	
b	0.330	0.510	0.013	0.020	
С	0.170	0.250	0.006	0.010	
D	4.700	5.100	0.185	0.200	
Е	3.800	4.000	0.150	0.157	
E1	5.800	6.200	0.228	0.244	
е	1.270 (中心到中心)		0.050 (中	心到中心)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050	
θ	0°	8°	00	80	



封装尺寸



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)		
	最小	最大	最小	最大	
А	3.710	4.310	0.146	0.170	
A1	0.510		0.020		
A2	3.200	3.600	0.126	0.142	
В	0.380	0.570	0.015	0.022	
B1	1.524 (中	心到中心)	0.060 (中心到中心)		
С	0.204	0.360	0.008	0.014	
D	9.000	9.400	0.354	0.370	
E	6.200	6.600	0.244	0.260	
E1	7.320	7.920	0.288	0.312	
е	2.540 (中心到中心)		0.100 (中4	心到中心)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142	
E2	8.400	9.000	0.331	0.354	

声明

必易确保以上信息准确可靠,同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易的产品整合到任何应用的过程中,应确保不侵犯第三方知识产权;未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失,必易不负任何法律责任。